




	<h2 style="color: #E67E22;">FQD2N100TM</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FQD2N100TM
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 1000V 1.6A DPAK
	Datenblätter:	 1.FQD2N100TM.pdf  2.FQD2N100TM.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 6627 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	FQD2N100TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 1000V 1.6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	6627 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	15 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 1000V 1.6A (Tc) 2.5W (Ta), 50W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 Ohm @ 800mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	520pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQD2N100TMCT

FQD2N100TM ist neu im Original. Suche FQD2N100TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD2N100TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD2N100TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD2N40 FAI FQD2N40 FAI</p>	 <p>FQD2N30 FAI FQD2N30 FAI</p>	 <p>FQD2N30TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 1.7A DPAK</p>	 <p>FQD2N100TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 1.6A DPAK</p>
 <p>FQD2N30TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 1.7A DPAK</p>	 <p>FQD2N100 FAIRCHILD FQD2N100 FAIRCHILD</p>	 <p>FQD2N100TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 1.6A DPAK</p>	 <p>FQD2N30TF VB FQD2N30TF VB</p>

heiße Teile

Mehr

FQD1N80TM	FQD1N80TM	FQD1P50TM	D FQD1P50TM	FQD20N06
FQD20N06-NL	FQD20N06L	D FQD20N06LE	FQD20N06LETM	FQD20N06LETM
FQD20N06LTF	FQD20N06LTF	FQD20N06LTM	FQD20N06LTM	FQD20N06LTU
D FQD20N06TF	FQD20N06TF	FQD20N06TM	FQD20N06TM	FQD24N08
FQD24N08TF	FQD24N08TF	FQD24N08TM	FQD24N08TM	FQD2N100
FQD2N100TM	FQD2N30TF	D FQD2N40TM	FQD2N40TM	FQD2N50B
FQD2N50C	D FQD2N50TF	FQD2N50TF	FQD2N50TM	FQD2N50TM
FQD2N60A	FQD2N60C	FQD2N60CTF	FQD2N60CTF	FQD2N60CTF-NL
FQD2N60CTF_F080	FQD2N60CTF_F080	FQD2N60CTM	D FQD2N60CTM	FQD2N60TM
FQD2N60TM	FQD2N65C	FQD2N80TM	FQD2N80TM	FQD2N80TM-NL

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

